⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-231396

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和60年(198	5)11月16日
H 05 K 9/00 G 02 F 1/133 H 01 B 5/14	118	6616-5F D-8205-2H A-7227-5E	審査請求	未請求	発明の数	2	(全4頁)

図発明の名称 半導体層を有する積層体

②特 願 昭59-88133

❷出 願 昭59(1984)5月1日

昌 降 名古屋市東区大幸町610番地 三菱レイヨン株式会社内 砂発 明 者 # 元 砂発 明 者 武 居 正 俊 名古屋市東区大幸町610番地 三菱レイヨン株式会社内 砂発 明 者 松 本 宏 之 名古屋市東区大幸町610番地 三菱レイヨン株式会社内 の出 顔 三菱レイヨン株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番19号

⑩代 理 人 弁理士 吉沢 敏夫

明 超 書

1. 発明の名称

半導体層を有する積層体

2. 特許請求の範囲

- 1 支持体上に利益可能な状態で半導体層が設 けられてなる半導体層を有する積層体。
- 2 半導体層が実質的に透明であることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の半導体層 を有する積層体。
- 支持体上に剥離可能な状態で半導体層が設けられ、次に該半導体層の上に接着剤層を設けてなる半導体層を有する積層体。
- 4 半導体層が異質的に透明であるととを特徴 とする特許請求の範囲第3項配収の半導体層 を有する積層体。

3.発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は、例えば導電材料の製造に用いる役 層体に関するものであり、さらに詳しくは影歴 可能な状態の半導体層を有する積層体に関する ものである。

〔従来技術〕

近年、表面を半導体の状態としたブラスチックは、電磁シールド材、センサー材料等の電子 機器分野に多用されており、特にこのうち透明 性ブラスチックを用いたものは、液晶ディスプ レイ、エレクトロルミネッセンスディスプレイ 等の薄型ディスプレイや電子写真の分野に、今 後将来性のある材料として脚光を浴びている。

ブラスチック表面を半導体の状態とするための一般的方法としては、例えば金属酸化物を蒸着もしくはスパッタリングにより薄膜を形成させる方法、無機塩、有機金属を強布後、無処理する方法、あるいは金属や金属酸化物を蒸着もしくはスパッタリングで薄膜を形成した後に酸化性雰囲気中で酸化処理する方法等が挙げられる。

しかしながら半導体膜とブラスチックとは通常接着強度が弱く、該接着強度を改善する方法が値々提案されている。例えば半導体層形成前

(1)

にプラスチック基体表面を放電処理、プラズマ 処理化学エッチング、コーテング処理等の予備 処理を施とすことによりプラスチック基体と半 等体との接着強度を向上させる試みがなされて いるが、いずれの予備処理によつてもその効果 は不充分なものであり、この結果半導体膜を被 びしたプラスチックの用途は制限されていると いうのが実状である。

しかも、透明な半導体階を形成させる場合に かいては、必ず高温下での酸化処理を必要とす るため基体として使用しうるブラスチック材料 は制限され、例えば光学特性に優れた耐熱性の 比較的低いポリメチルメタクリレート等の透明 ブラスチックへの応用は不可能に近い状況にあ る。

[発明の目的]

本発明の目的は、一般のブラスチック基体の 上に半導体層を密着性よく転写でき、しかも支 持体から容易に剝離させて転写のできる半導体 層を有する積層体を提供することにある。

(3)

可能とするために支持体は酸化処理時の熱に耐 えられる耐熱性を有するものであることが望ま しい。

本祭明に用いる支持体についてさらに説明す るとこの支持体は、半導体の種類に応じて任意 の材質を選択することができ、支持体の形状に ついてもシート状、板状、又はフィルム状のい ずれも可能であり、目的に応じて選択すればよ い。これらの支持体の具体例としては無機物、 金属及びフツ雲系樹脂、フェノール樹脂、芳香 族ポリスルフォン、芳香族ポリアミド、芳香族 ポリイミド、シリコン樹脂等の耐熱性に優れた 樹脂あるいはポリエステル樹脂、セルロース樹 脂等の表面にフッ葉系樹脂やシリコン系樹脂等 の耐熱性と離形性に優れた樹脂をコーティング したものが挙げられる。なお、金周又は無機物 を支持体として用いる場合には、該支持体の上 に形成される 透明導電層と高い 製和性を有する ととから、放支将体に前述したような離形性を 付与する処理を行なりことが叙ましい。

[発明の構成]

本発明は、上記の目的を達成するためになされたもので、支持体上に半導体層を設けてなる半導体層を有する機関体を第一の発明とし、支持体上に半導体層を設け、次に該半導体層の上に接着剤層を設けてなる半導体層を有する積層体を第二の発明とするものである。

本発明において用いられる半導体としては、 例えば酸化スズ、酸化インジウム、酸化の だい で の名は、沃化銀等が挙げられ、目的に応じてものに で選することができるが、特にこれらのもに 限定されるものではない。又、半導体層が選 なものであるときには、例えば金属や金属酸化 物を支持体上に蒸痩又はスペッタリングで製 を形成し、この後に酸化性雰囲気中である。 処理することにより得ることが可能である。

本発明における支持体は、その上に形成される半導体層と散支特体とが剥離し易いものであることが必要である。又、半導体が透明である。ものの場合においては、高温下での酸化処理を

(4)

本発明によつて得られた半導体層を有する機 層体は、数半導体層を一般のブラスチック基体 上に転写するととがあるととからに支持 体上に形成された半導体層の上にを前間を 体上に形成された単体優れた接着 をしたができる。とれたで表別面に を対していたができる。を では、本でではないでは、 を対していたができる。というでは、 を対していたができる。というでは、 を対していたができる。というでは、 を対しているというでは、 を対しているというでは、 を対しているというでは、 を対している。 をがいている。 をがいる。 をがい。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。 をがいる。

尚、本発明の半導体層を有する根層体が半導体層上に接着剤層を有していたい場合には、該 半導体層を転写するプラスチック基体上に予め 接着剤層を散けておけばよい。

本発明の半導体層を有する積層体は、主として一般のブラスチックを対象とし、この表面に 半導体層を有する導電性に優れた材料を製造す るために用いられるが、その方法としては以下 に示す方法等が挙げられる。

すなわち本苑明の半導体層を有する積層体と、 一般のブラスチック基体とを、接着剤脂を介し て前者の半導体層が接着剤層と接触するように 圧着する。このとき投着剤層は圧着前に半導体 層の上か又はブラスチック基体の上に設けてあ nHIV.

とのようにして得られた積層物を接着剤硬化 処理により接着剤層を硬化させ、しかる後、支 将体を剥離する。とれによつて半導体層の特性 を扱うことなく一般のブラスチック基体上に半 導体層を転写することができ、しかも半導体層 は該プラスチック基体に強固に密着した導電性 ブラスチックを得ることができる。

ことで対象となるブラスチック 基体としては、 例えばポリメタクリル系、ポリアクリル系、ポ リオレフイン系、ポリアミド系、ポリエステル 系、ポリスチレン系、ポリ塩化ピニル系あるい はこれらの共重合体などが挙げられるが、これ らに限定されるものではない。

(7)

摩擦子とし、加速1009/cm2で100回摩擦) を実施しても表面抵抗値に変化は認められなか つか。

く実施例2>

実施例1と同様にして「テフロン」フィルム の表面に透明導電層を形成し、さらにとの上に アクリル系樹脂を強布し半導体層を有する積層 体を得た。とれを実施例1と同様に表面を酸化 机造したポリエチレンシートに圧着させ実施例 1 と同様の評価を行なつたところ、テフロンフ イルムは容易に剥離することができ、かつ転写 状態も優れていた。又、転写後の導電性は転写 前に比べて全く変化は認められず、表面抵抗値 は10°Ω/□であつた。又、転写袋のポリエチ レンシートは光透過率が7 0 多以上(6 3 0 mm 単色光の透過率)であつた。

さらに転写後の半導体層は摩擦試験(赭布を 摩擦子とし、加速 100g/cm²で 100回摩擦) を実施しても表面抵抗値に変化は認められなか つた。

次に本発明を実施例により説明する。

支持体として「テフロン」(デユポン社製フ ッソ来ポリマーシート)フィルムを用い、との テフロンフィルム上に通常の蒸着手段でインジ ウムノスズ(重量比95:5)の蒸滞襲を形成 し、その後300℃のオープン中で2時間無処 選し、半導体層を有する積層体を得た。

得られた半導体層は透明なものであり、その 表面抵抗は1030/口 であつた。

上記積層体の特性を評価するために、アクリ ル系接着剤を筺布したポリメチルメタクリレー ト板上に眩澹層体を半導体層がポリメチルメタ クリレート板上の接着剤層に接触するようにし て圧着し、支持体の副離性及び転写径の半導体 層の導電性を調べた。その結果、「テフロン」 フィルムは容易に別離することができ、かつ転 写状態も優れていた。又、転写後の導電性は転 写前に比べて全く変化は認められなかつた。

さらに転写後の半導体層は摩擦試験(綿布を

(8)

[発明の効果]

以上許述したように本発明の半導体層を有す る費層体は一般のプラスチック基体上に半導体 `層を密溜性よく転写でき、しかも支持体から容 易に剝離することができるものであり、その効 来は題巻たものである。

人図面の無単た説明

館1図及び第2図は本発明の半導体層を有す る積層体の断面図を示す。

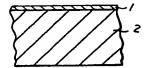
1 •••• 半導体層

2 ***** 支持体

5 经 查 刻 层

特許出屬人 代理人 弁理士

第/図



第2 図

